

VIỆN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG  
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

-----  
**MÔN HỌC: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ**  
**Học kỳ: 2    Năm học: 2013-2014**

**BÀI TẬP VỀ NHÀ SỐ 4**

Bài 1 (10 điểm)

Hãy kẻ bảng so sánh các loại bộ nhớ EPROM, EEPROM, Flash, SRAM, DRAM theo các tiêu chí:- Cấu trúc 1 bit nhớ, giá thành, thời gian đọc, thời gian ghi, mức tiêu thụ năng lượng, kích thước tối đa của 1 IC, khả năng lưu giữ thông tin, ứng dụng.

Bài 2 (10 điểm) Tải datasheet của EPROM 2716 từ

<http://www.futurlec.com/Datasheet/Memory/2716.pdf>

- a. Giải thích sơ đồ thời gian trên hình 5.
- b. Vì sao EPROM có thời gian truy cập 450 ns không thể nối trực tiếp với 8088 làm việc ở tần số 5 MHz.

Bài 3 (10 điểm)

Vào trang web: [www.alldatasheet.com](http://www.alldatasheet.com) tải datasheet của IC SST29EE010. Giải thích sơ đồ thời gian trên hình 4 (read cycle timing diagram).

Bài 4 (10 điểm)

Bài 31 trang 360 của sách tham khảo.

Bài 5 (10 điểm)

Bài 32 trang 360 của sách tham khảo.

Bài 6 (10 điểm)

Bài 46 trang 361 của sách tham khảo

Bài 7 (10 điểm)

Bài 47 trang 361 của sách tham khảo

Bài 8 (20 điểm)

Thiết kế bộ nhớ cho 8086 với các thông số sau:

80 KB RAM từ các IC SRAM dung lượng 8Kx8 bắt đầu từ địa chỉ 0C000H

128KB ROM từ các IC ROM dung lượng 32Kx8 kết thúc tại địa chỉ FFFFFH